

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共9项，其中自主可控 A 级0项、B 级9项、C 级0项、C*级0项、D 级0项、E 级0项；伪国产化0项、包装国产化0项、空心国产化0项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^e
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	锂电池充电管理	JTLX4040YTDE8	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	锂电池充电管理	JTLX4040YTDE8(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	锂电池充电管理	TLX4040YTDE8	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
4	锂电池充电管理	JTLX4040AYTDE8	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	锂电池充电管理	JTLX4040AYTDE8(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	锂电池充电管理	TLX4040AYTDE8	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
7	锂电池充电管理	JTLX4040BYTDE8	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
8	锂电池充电管理	JTLX4040BYTDE8(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
9	锂电池充电管理	TLX4040BYTDE8	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填表说明：

^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；

^b. 应填写元器件完整型号规格；

填报单位（盖章）：



法定代表人（签章）：

汤景明

填表人（签字）：

侯仕颖

电话：13699386074 填报日期：20251231

^c. 应填写元器件生产厂商中文全称，勿填写代理商；

^d. 按照 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行，分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级，针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行；

^e. “伪、空、包”应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为“是”时，则需要“情况说明”写明判别因素；若为“否”时，则填“无”；

^f. 若存在其他需要说明的情况，可在备注栏填写。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

汤学研

填表人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20251231

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^e		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	锂电池充电管理	JTLX4040YTDE8	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				
2	锂电池充电管理	JTLX4040YTDE8 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				
3	锂电池充电管理	TLX4040YTDE8	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				
4	锂电池充电管理	JTLX4040AYTDE8	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				
5	锂电池充电管理	JTLX4040AYTDE8 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				
6	锂电池充电管理	TLX4040AYTDE8	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				

填报单位(盖章):



法定代表人(签章):

汤景明

填表人(签字):

侯仕颖

电话: 13699386074 填报日期: 20251231

7	锂电池充电管理	JTLX4040BYTDE8	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯 半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				
8	锂电池充电管理	JTLX4040BYTDE8 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯 半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				
9	锂电池充电管理	TLX4040BYTDE8	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	艾美杰斯 半导体	境内	0.18um BCD	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	宿迁长电				

填表说明:

- ^a. 应是元器件全称，与详细规范或产品技术资料上的名称相符；
- ^b. 应填写元器件完整型号规格；
- ^c. 仅适用于半导体集成电路，应填写 IP 核类型，包括“软核”“固核”“硬核”；
- ^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写，至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料，同时也应包含外壳、引出端、键合丝等，不包含灌封料等生产过程材料；
- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”，非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填；
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写，不能按代理商填写；对来源不明的，应填写“来源不明”，具体判定时视为“境外”；
- ^g. 仅适用于半导体集成电路，应填写流片工艺名称，如 45nmBCD 工艺等，必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章):

汤学明

填表人(签字):侯仕颖 电话:13699386074 填报日期:20251231